# QCMによる金属上へのチタニア被膜生成反応の解析(第2報)

金属系チーム 塩見 昌平, 丸岡 智樹, 南 秀明

#### 要 旨

チタン酸化物であるチタニアは、光触媒活性を示す機能性酸化物として広く知られており、実用化に向けて、単 位体積あるいは単位質量あたりの反応面積が大きいチタニア電極の作製が求められている。我々は、チタニア電極 の作製法として、特殊な装置等を必要とせず、液相中での化学反応を利用した簡便な手法であるゾル-ゲル法に着 目し、ナノオーダーで表面形態を制御した金属構造体上にゾル-ゲル法を用いて薄層のチタニアを析出させること で大表面積のチタニア電極をきわめて簡便に作製することができると考えた。金属ナノ構造体上に薄層のチタニア 被覆を施すためには、金属上へのゾル-ゲル法によるチタニアの析出反応を制御し、目的のチタニア膜を得るため の条件を最適化することが非常に重要である。金属上へ所望のチタニア膜を析出させるための反応浴条件の最適 化手法としては、これまでに、水晶振動子(QCM)を用いた評価手法を提案しており、本研究ではこれを用いて実 際にチタニア析出挙動の評価を行うとともに、液相還元法により金属ナノ構造体であるNiナノワイヤーを作製し、 ナノワイヤー上への薄層チタニア被膜形成について検討を行った。その結果、前駆体添加量を制御することでNi 基板上へのチタニアの不均一核生成が促されることが分かり、液相還元法により作製したNiナノワイヤー上にチ タニア膜を形成することができた。

# 1. はじめに

チタンの酸化物であるチタニア(TiO<sub>2</sub>)は、古くか ら白色顔料等の用途で用いられてきた材料であり、化 粧品用紫外線遮蔽剤としても利用されている<sup>1.2)</sup>。近 年では、光照射による電子状態の変化に起因する光触 媒効果を利用し、空気清浄、水浄化、抗菌、脱臭、防 汚、防曇などへ用途展開が進んでいる<sup>3)</sup>。また、チタ ニア上に担持させた色素を介した酸化還元反応を利用 する色素増感太陽電池としての応用も検討されている 他、電極を接続して適切な回路を組むことで光によっ て水が分解され水素と酸素が発生する現象も本多-藤 嶋効果として広く知られている<sup>4.5</sup>。

チタニア電極を作製する方法として広く用いられて いる手法としては、チタニア粉末を溶媒中に分散させ スピンコートやスクリーン印刷等により電極上に塗布 するものである<sup>6)</sup>。この手法では、微細なチタニア粉 末を材料として用いることにより反応面積を大きくす ることができるという長所を有しているが、一方で、 一度作製したチタニア粉末を溶媒中に均一に分散させ る工程が必要である点やバインダーの選択が必要であ る点において問題を抱えている。その他のチタニア電 極の作製法としては、ゾルーゲル法<sup>7)</sup>を利用したディッ プコーティング法がある。この方法は、コーティング 液に基板を浸漬し引き揚げることにより膜を得る非常 に簡便な手法であるが<sup>8)</sup>,溶液の調製における前駆体, 溶媒,触媒,安定化剤等の種類および濃度の最適化や, 引き揚げ速度の適切なコントロール等が必要であり経 験やノウハウが求められるだけでなく,析出する膜の 形態や膜厚の制御が困難であるという課題を有してい る。

ゾル-ゲル法は、金属アルコキシド等を前駆体とし、 溶液中での化学的な反応によりゾル、ゲルを経て酸化 物を得る方法であり, 蒸着やスパッタ等のように特殊 な真空装置や環境を必要とせず非常にシンプルな手順 で簡便に酸化物を作製することができ、生産性に優れ ている<sup>9)</sup>。ゾル-ゲル法による酸化物の生成反応は前 駆体や触媒等の種類、濃度に大きく左右され、特にチ タニアを析出させる反応は速度が非常に大きく制御が 困難であるとされてきた10)。しかしこれまでの研究で 我々は、チタンテトライソプロポキシドを前駆体とし て用いるゾル-ゲル法において浴組成を適切にコント ロールすることにより、 金属基板を浴中に浸漬させて おくことで液中での均一核生成だけでなく金属基板上 への不均一核生成が起こることを見出し、基板をチタ ニアで被覆できることを示した。さらに、このような 均一核生成あるいは不均一核生成挙動について、水晶 振動子 (QCM) を用いたその場測定による評価を検討 してきた11)。

チタニア電極の実用化に向け、単位体積あるいは単 位質量あたりの反応面積を大きくすることは非常に重 要な検討課題であり、そのためには、大比表面積を有 した基材上にチタニアを析出させることが求められ る。そこで本研究では、チタニアを析出させる基材と して、ナノ構造を有するため表面積が非常に大きく、 かつ、導電性を兼ね備えた材料であるNiナノワイ ヤー<sup>12)</sup> に着目した。例えば、質量1gの立方体のNi と線径100nmのナノワイヤー状のNiの表面積とを比 較すると、ワイヤーは立方体の約32000倍もの表面積 を有している計算になり、反応面積が非常に大きい電 極としての利用が期待できる材料であるといえる。Ni ナノワイヤーの作製については、これまで我々が行っ てきた液相還元法による金属ナノ粒子の合成技術<sup>9,13)</sup> を応用して達成することができる。具体的には、液相 還元法によりNiナノ粒子を作製する際,反応浴に外 部から磁場を印加することにより、Niが強磁性体で あることを利用してNiナノ粒子を配列させ、ナノワ イヤーを得るものである。こうして得られた Niナノ ワイヤーの大きな特徴として、ナノ構造を有し大きな 比表面積を持ちながら、不織布のような形態で析出す るためハンドリングが容易であることが挙げられ、新 しい発想のLiイオン電池用電極としても応用が検討 されている14)。このようなナノワイヤー上にチタニア を薄く均一に被覆することができれば、粉末の塗布と いった煩雑かつ剥離等のエラーが生じ得る手法を用い ることなく、大比表面積のチタニア電極を簡便に作製 することができる。

本報では, 既報<sup>11)</sup> に倣ったQCMによるNi基板上へ のチタニア析出挙動の評価を行い, これまで報告して きたAu基板上へのチタニア析出挙動との相違点を確 認するとともに, 液相還元法によるNiナノワイヤー の作製ならびにNiナノワイヤー上への薄層チタニア 被膜の生成について検討する。

# 2. 実験方法

#### 2.1 試薬,材料等

本実験に使用した試薬は、和光純薬工業株式会社 製特級2-プロパノール ((CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CHOH)、アンモニア 水 (NH<sub>3</sub>, 28%)、塩化ニッケル (II) 六水和物 (NiCl<sub>2</sub>・ 6H<sub>2</sub>O)、くえん酸三ナトリウム二水和物 (C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>Na<sub>3</sub>O<sub>7</sub>・ 2H<sub>2</sub>O)、ヘキサクロロ白金 (IV) 酸六水和物 (H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>・ 6H<sub>2</sub>O)、水酸化ナトリウム (NaOH)、ヒドラジン一水 和物 (N<sub>2</sub>H<sub>4</sub>・H<sub>2</sub>O), 一級チタンテトライソプロポキ シド (Ti[OCH (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]<sub>4</sub>, 以降 TTIP と表記) であり, 精製は行わずそのまま使用した。なお, ヘキサクロロ 白金 (IV) 酸六水和物はイオン交換水に溶解させ0.01M 水溶液として, 水酸化ナトリウムはイオン交換水に溶 解させ4.0M 水溶液として使用した。

#### 2.2 QCMによるチタニア被膜析出挙動の解析

2-プロパノール40mlにチタニアの前駆体である TTIPを添加し、マグネチックスターラーを用いて十 分撹拌し均一な溶液とした後、撹拌を続けながらアン モニア水を添加してゾル-ゲル反応を開始させた。反 応中のチタニア析出挙動を評価するため、浴に最表 面がNiスパッタされたQCM 基板(QA-A9M-NI(M)) を浸漬させ、セイコーEG&G社製QCM922Aを用いて 周波数変化をモニタリングした。なお、QCMにより 測定された周波数変化は, Sauerbrey 式<sup>9,11,12)</sup> を用い て基板上に析出した物質の質量変化に換算した。添 加するTTIP/アンモニア水を2.0/1.0, 2.0/0.5, 2.0/0.1, 1.0/1.0, 0.5/1.0, 0.2/1.0, 0.2/0.1 (ml) とさまざまに変 化させ、これらの添加量がチタニア生成に及ぼす影響 を調べた。反応時間は60分間とし、反応後のQCM基 板をエタノールで洗浄した後、表面状態をレーザー顕 微鏡(オリンパス株式会社製LEXT OLS4100)を用い て観察した。

# 2.3 Niナノワイヤーの作製とチタニア被覆

金属塩溶液として、0.1M塩化ニッケル、37.5mMく えん酸三ナトリウム、0.2mM ヘキサクロロ白金(IV) 酸を含んだ水溶液10mlを調製し、水酸化ナトリウム 水溶液を用いてpHを12.5とした。還元剤溶液とし て、1.0Mヒドラジン水溶液10mlを調製し、水酸化ナ トリウム水溶液を用いてpHを12.5とした。これらの 溶液を混合し、外部から磁場を印加した状態で、 温度 353Kのもとで120分間反応させた。Niナノワイヤー 析出反応の模式図を図1に示す。上記手法で作製した Niナノワイヤーおよそ0.06gを2-プロパノール40ml に浸漬させ、TTIPを0.2ml添加し、メカニカルスター ラーを用いて十分撹拌し均一な溶液とした後, 撹拌 を続けながらアンモニア水1.0mlを添加して60分反応 させた。作製したNiナノワイヤーおよびチタニア被 膜の形態は、電界放出型走査電子顕微鏡(日本電子製 JSM-6700F. 以下SEM) および電界放出型透過電子顕



微鏡(日本電子製JEM-2100F,以下TEM)を用いて 観察した。また,被覆処理を施したNiナノワイヤー に対し773Kで60分間の熱処理を施し,X線回折装置 (Rigaku製SmartLab,以下XRD)を用いて結晶構造 解析を行った。

### 3. 結果及び考察

# 3.1 種々の浴組成におけるチタニア被膜析出挙動の 変化

反応浴に添加したTTIP/アンモニア水を2.0/1.0, 2.0/0.5, 2.0/0.1 (ml), すなわち, TTIP添加量を固 定してアンモニア水添加量を減少させていったとき のQCM測定結果を図2aに, TTIP/アンモニア水を 2.0/1.0, 1.0/1.0, 0.5/1.0, 0.2/1.0 (ml), すなわち, ア ンモニア水添加量を固定してTTIP添加量を減少させ ていったときのQCM測定結果を図2bに, TTIP/ア ンモニア水を2.0/0.1, 0.2/1.0, 0.2/0.1 (ml) とした際 のQCM測定結果を図2cに示す。

浴条件を変化させた際のNi基板上へのチタニア析 出挙動は,既報<sup>11)</sup>で得られたAu基板上への析出挙動 とほぼ同様の傾向を示した。すなわち,TTIP/アン モニア水添加量2.0/1.0の条件からTTIP添加量を固定 しアンモニア水添加量を減少させていくと(図2a), 60分間反応後のQCM基板上のチタニア析出量は減 少していくこと,また,アンモニア水添加量を1.0ml で固定しTTIP添加量を減少させていくと(図2b), 1.0mlに半減させた場合は均一核生成が顕著に起こり QCM基板上への析出量はTTIP添加量とは比例せず 大きく減少するが,0.5ml以下になれば均一核生成頻 度の増加がそれ以上起こらず,むしろ不均一核生成が



図2 TTIP/アンモニア水添加量を(a)2.0/1.0,2.0/0.5,2.0/0.1, (b)2.0/1.0,1.0/1.0,0.5/1.0,0.2/1.0, (c)2.0/0.1,0.2/1.0,0.2/ 0.1(ml)とした際のチタニア析出反応中のNi基板上 における析出物の質量変化

促され、QCM基板上への析出が起こりやすくなるこ とが分かった。ただし、TTIP添加量が0.2mlのとき は、アンモニア水の添加量によらずほぼ同様のチタニ ア析出挙動を示したことから(図2c)、TTIP添加量 が少ないときは浴中に存在するTTIP量のみがチタニ ア膜の生成反応速度を決定づける因子であることが 示唆された。この結果は、TTIP/アンモニア水添加量 が0.2/0.1の場合に持続的に質量増加が観察されたAu のQCM基板を用いた際の結果とは少し異なるもので あったが、TTIP添加量が0.2mlのQCM測定は、基板 上への析出量が非常に小さい領域での議論であり、室 温や湿度など、微妙な環境の変化による影響を受けて いる可能性もあるため、今後、より精密な測定が必要 であることが分かった。

各TTIP, アンモニア水添加量で60分間反応さ せた後のQCM 基板のレーザー顕微鏡像を図3に示 す。QCM測定で最も析出量が多かったTTIP/アンモ ニア水添加量2.0/1.0の条件で60分間反応させたもの (図3a) については、厚い膜が基板上に不均一に形 成されたことから、この条件では激しく反応が進行 し、均質な薄膜を得るには制御が難しかったことが分 かる。アンモニア水の添加量を0.5ml, 0.1mlと減少さ せた場合, QCM測定結果(図2a)から予測された通 り、確かにチタニアの析出量は減少しているように見 えるが、析出したチタニア膜は依然としてNi上にま ばらに形成されており、膜の形態制御は困難であった (図3b, c)。一方, TTIP添加量を1.0ml, 0.5ml, 0.2mlと減少させると、基板上にはより均質かつ薄い 膜が形成されることが確認できた(図3d-f)。すな わち、Ni 上への薄層チタニア被膜の形成を実現する ためには、浴中に存在する前駆体の量の制御が重要 であるといえる。また、TTIP/アンモニア水添加量が 0.2/1.0のものからアンモニア水添加量を減少させた 0.2/0.1の条件(図3g)では少し斑が生じていたこと



図 3 TTIP/アンモニア水添加量を(a)2.0/1.0,(b)2.0/0.5,(c) 2.0/0.1,(d)1.0/1.0,(e)0.5/1.0,(f)0.2/1.0,(g)0.2/0.1(mI) とした際の反応後のQCM基板のレーザー顕微鏡像 から、本実験では、最も均質かつ薄層のチタニア被膜 を生成可能な条件としては、TTIP/アンモニア水添加 量が0.2/1.0のものであった。

#### 3.2 Niナノワイヤーのチタニア被覆

作製したNiナノワイヤーのSEM像を図4に示す。 線径数10nmから200nm程度かつ長さ方向にきわめて 長いナノワイヤーが作製されたことがわかる。本実験 で析出したNiの質量はおよそ0.06gであった。

本実験において最も均質かつ薄層のチタニア被膜 が生成したTTIP/アンモニア水添加量0.2/1.0の条件で 60分間チタニア被覆処理を施したNiナノワイヤーの SEM像ならびにTEM像を図5に示す。QCMで確認 されたように,確かにチタニアがNi上に析出し,Ni ナノワイヤーがチタニア薄膜によって被覆された構造 を作製できた。ただし、場所によっては1本ずつのナ ノワイヤーが個別に被覆されず束になったナノワイ ヤーを纏めて被覆するようにチタニアが生成した箇所 が見られ,被覆層の厚さにも微視的にはばらつきがあ ることが分かった。

ゾル-ゲル法により生成したチタニアは作製直後の



図4 液相還元法により作製したNiナノワイヤーのSEM 像(右は拡大図)



図5 TTIP/アンモニア水添加量0.2/1.0mlの条件でチタ ニア被覆したNiナノワイヤーのSEM像(上)および TEM像(下) 段階ではアモルファスの状態であり、適切な熱処理 を施すことにより結晶化が起こることが分かってい る<sup>15)</sup>。そこで、チタニア被覆されたNiナノワイヤー に773Kで60分間熱処理を施した。熱処理後のチタニ ア被覆NiナノワイヤーのXRDプロファイルを図6に 示す。Niナノワイヤーに由来するFCCのピークが大 きく検出されたが、アナターゼ型のチタニアに由来す るピークも僅かではあるが検出されたことから、Ni ナノワイヤー上に形成された被膜は確かにチタニア膜 であり、昨年度までの報告と同様773Kの熱処理でア ナターゼへと結晶化することが確認できた。





# 4. まとめ

大表面積を有したチタニア電極の作製を目指し,本 研究では、ゾル-ゲル法におけるNi上へのチタニア の析出挙動の解析を行い浴条件の最適化を行うととも に、実際に大表面積を有した金属基材であるNiナノ ワイヤー上へのチタニア被膜の形成を試み、以下の知 見を得た。

- 1. TTIPを用いたゾル-ゲル法によるチタニア析 出プロセスをQCM測定により解析するにあたり, QCM基板としてNiを用いた場合の測定結果は, Au基板を用いた場合の結果と同様の傾向を示し, TTIP添加量をある一定量よりも減少させること で基板上への不均一核生成が促されることを確認 した。
- 2. 磁場中での液相還元法により、水溶液中でNi

ナノワイヤーを作製できた。また、QCM測定に 基づき最適化した、不均一核生成が促されかつ薄 い膜が形成されるような浴条件を採用し、Niナ ノワイヤーのチタニア被覆を試みたところ、ナノ スケールでは膜厚や被覆状態にばらつきはあるも のの、Niナノワイヤー上にチタニア膜を形成す ることができた。

 
 ・作製したチタニア被覆Niナノワイヤーを773K で熱処理したところ、チタニアが結晶化し、アナ ターゼ型の結晶構造をとることがXRDによって 確認された。

#### 付 記

本研究で使用した電界放出型走査電子顕微鏡,電界 放出型透過電子顕微鏡はそれぞれ平成15年度,平成 28年度日本自転車振興会JKA設備補助事業により設 置された装置であり,付記して謝意を表す。

#### 参考文献

- 1) 福井寛:色材, 72,633 (1999).
- 2) 作花済夫: "ゾル-ゲル法応用の展開", シーエム シー出版 (2000).
- 3) 藤嶋昭:表面技術, 55, 310 (2004).
- 4) B. O'regan, M. Gratzel: Nature, 353, 737 (1991).
- 5) A. Fujishima, K.Honda : Nature, 238, 37 (1972).
- 6) S. Ito, 他: Chem.Mater., 15, 2824 (2003).
- 7)作花済夫: "ゾルーゲル法の科学",アグネ承風社 (1988).
- 8) P. C. Innocenzi, 他: J. Eur. Ceram. Soc., 10, 431 (1992).
- 9) S. Shiomi, 他: J. ColloidInterf.Sci., 460, 47 (2015).
- 10) 土岐元幸:表面技術, 50, 161 (1999).
- 11) 塩見昌平, 他:京都市産業技術研究所研究報告 No.6, 7 (2016).
- 12) M. Kawamori, 他: J. Electrochem. Soc., 158, E79 (2011).
- 13) 塩見昌平, 他:京都市産業技術研究所研究報告 No.4, 28 (2014).
- 14) M. Kawamori, 他: NanoLett., 14, 1932 (2014).
- 15) 塩見昌平, 他:京都市産業技術研究所研究報告 No.5, 28 (2015).